

Procedeu de creștere a structurii $n^+ - p - p^+ \text{InP}$ pentru celule solare, care constă în aceea că substratul de $p^+ \text{InP}$ cu orientarea cristalografică (100), dezorientarea de $3...5^\circ$ spre (110) și concentrația purtătorilor de sarcină de $1...3 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ se prelucrează în toluen și alcool izopropilic, se corodează în soluție de 5% Br_2 în metanol, se spală în alcool izopropilic, se usucă în vaporii acestuia și se plasează într-un reactor pe un suport, se purjează reactorul cu hidrogen timp de 1 oră, se stabilește în acesta temperatura de 670°C , se corodează substratul cu HCl , se crește stratul de $p \text{InP}$ cu grosimea de $10 \mu\text{m}$, se corodează cu HCl reactorul și stratul de $p \text{InP}$, pe care se crește stratul de $n^+ \text{InP}$, se scoate semifabricatul obținut din reactor, se depune contactul ohmic din $\text{Ag} + 5\% \text{Zn}$ pe p^+ , care se tratează termic la temperatura de 500°C , ulterior se depune un contact ohmic din In pe substratul de $n^+ \text{InP}$ și se tratează termic la temperatura de 250°C .